




| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">STI33N60M2</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | STI33N60M2 |
|  | Hersteller / Marke: | STMicroelectronics |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 600V 26A I2PAK |
| Datenblätter: |  STI33N60M2.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 20 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | STI33N60M2 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 26A I2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 20 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | I2PAK (TO-262) |
| Serie | MDmesh™ II Plus |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 125 mOhm @ 13A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 190W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1781pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 45.5nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 26A (Tc) |

STI33N60M2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STI33N60M2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STI33N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STI33N60M2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>STI30N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 22A I2PAK</p> |  <p>STI300N4F6 STMicroelectronics MOSFET N CH 40V 160A I2PAK</p> |  <p>STI33N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A I2PAK</p> |  <p>STI3406 SUNTO STI3406 SUNTO</p> |
|  <p>STI3400DCV ST STI3400DCV ST</p> |  <p>STI32N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A I2PAK</p> |  <p>STI3400DVC ST STI3400DVC ST</p> |  <p>STI28N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 22A I2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| STI33N60M2 STMicroelectronics | STI33N60M2 Datenblatt | STI33N60M2-Datenblätter | STI33N60M2 PDF | STMicroelectronics STI33N60M2 |
| STI33N60M2 Electronic | STI33N60M2-Komponenten | STI33N60M2-Verteiler | STI33N60M2-Bild | STI33N60M2-Teil |
| STI33N60M2 Preis | STI33N60M2 Hersteller | STI33N60M2 Bild | STI33N60M2 Aktie | STI33N60M2 Inventar |
| STI33N60M2 Neu | STI33N60M2 Original | STI33N60M2 garantiert | STI33N60M2 RFQ | STI33N60M2 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited